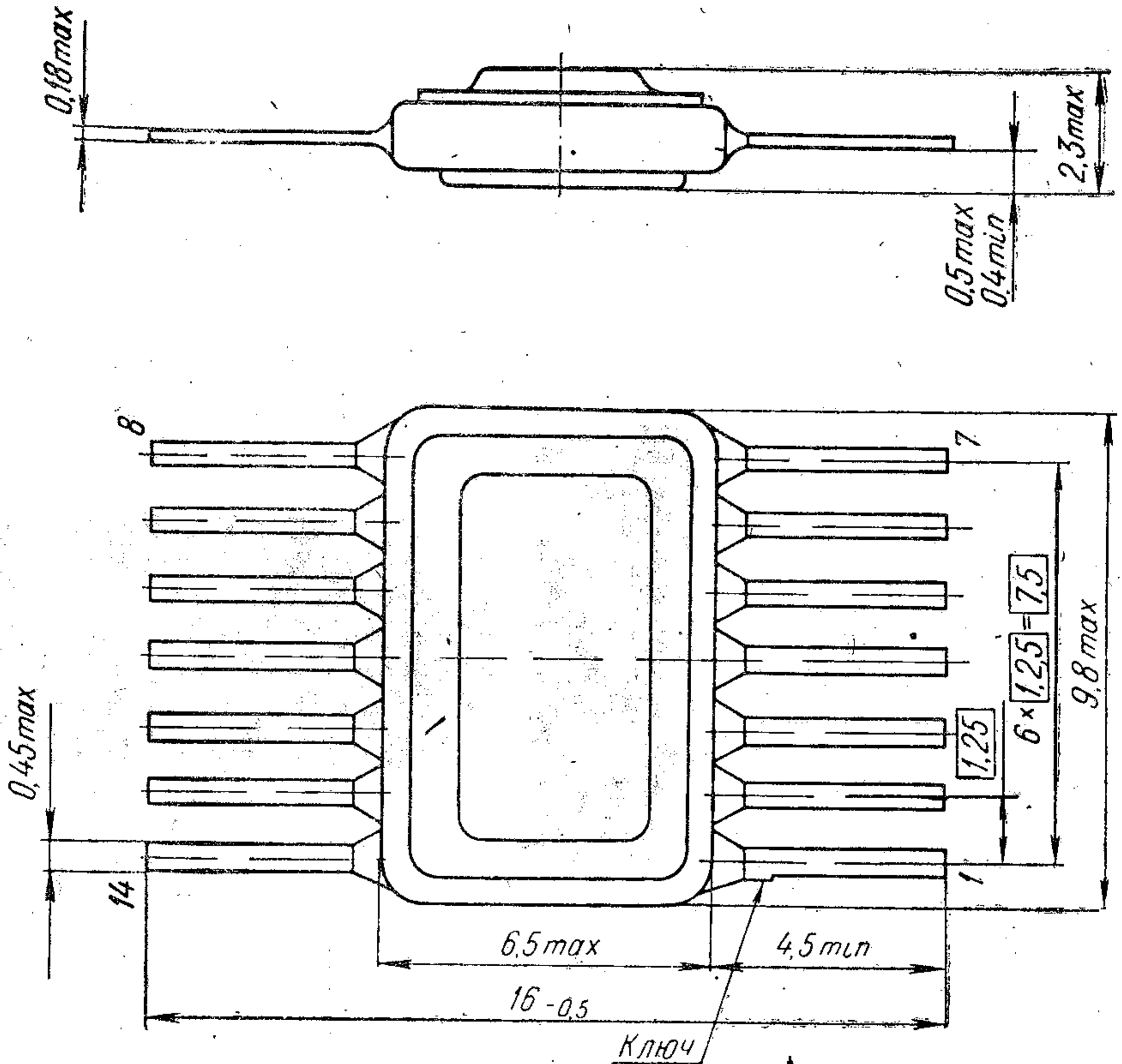


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 185

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМ 185РУ1, 185РУ2, 185РУ3 (КОРПУС 401.14-4)



Масса не более 0,35 г

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 185

Общие данные

Механический удар многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	140
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	$1,33\cdot 10^{-4}$ (10^{-6})
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, $^{\circ}\text{C}$	85
Пониженная температура среды, $^{\circ}\text{C}$	минус 60
Изменение температуры среды, $^{\circ}\text{C}$:	
от повышенной	125
до пониженной	минус 60
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ^О , ч	50 000
Срок сохраняемости ^О , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

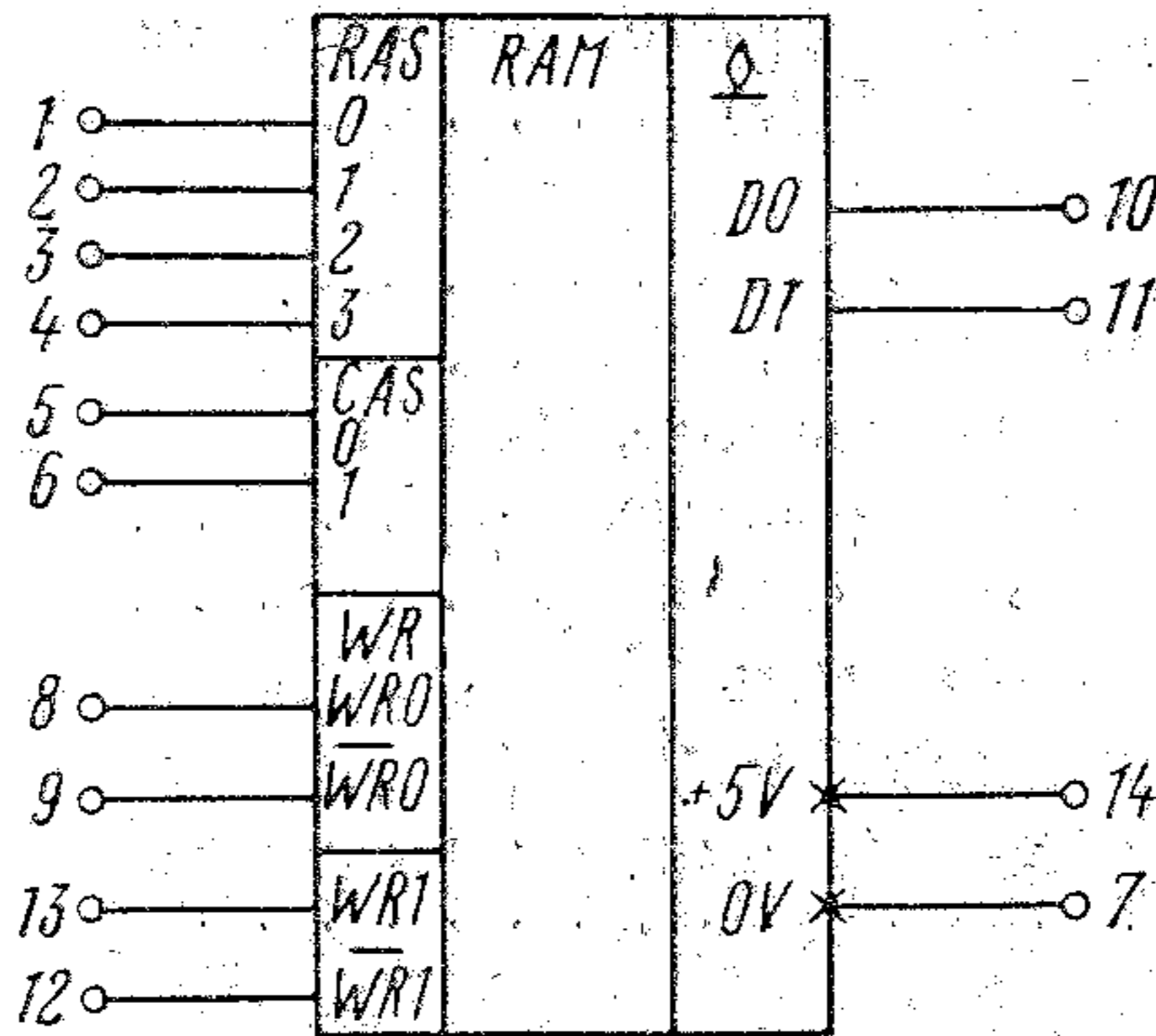
Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Установка микросхем на платы производится вплотную или с зазором до 0,7 мм с последующей прилакировкой и приклеиванием клеем.

При монтаже микросхемы в аппаратуре должны быть приняты меры, исключющие: изгиб выводов ближе 1 мм от края корпуса микросхемы с радиусом закругления менее 0,36 мм; монтаж микросхемы, находящейся под напряжением; кручение выводов в плоскости корпуса микросхемы.

^О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- 1 — вход адресный RAS0
- 2 — вход адресный RAS1
- 3 — выход адресный RAS2
- 4 — вход адресный RAS3
- 5 — вход адресный CAS0
- 6 — вход адресный CAS1
- 7 — общий
- 8 — вход записи «0» первого разряда WRO
- 9 — вход записи «1» первого разряда WRO

- 10 — выход первого разряда D0
- 11 — выход второго разряда D1
- 12 — вход записи «1» второго разряда WRI
- 13 — вход записи «0» второго разряда WRI
- 14 — +5 В

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25±10°C)

Напряжение питания, В	5±10%
Ток потребления в режиме хранения информации, мА, не более	4,7
Выходное напряжение низкого уровня, В, не более	0,37
Входной ток, мкА, не более:	
низкого уровня	
по входам 1—4	540
» » 5, 6	1040
» » 8, 9, 12, 13	470

высокого уровня	
по входам 8, 9, 12, 13	60
Выходной ток высокого уровня, мкА, не более . .	15
Помехоустойчивость, В, не более	0,4
Время выборки адреса, нс, не более:	
при включении	100
» выключении	120
Входная емкость, пФ, не более:	
по входам 1—4	3,5
» » 5, 6	5,5
» » 8, 9, 12, 13	3,0

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания, В:	
максимальное	5,5
минимальное	4,5
Максимальный ток потребления в режиме обра- щения, мА	20
Входное напряжение, В:	
низкого уровня по адресным входам	0,4
высокого уровня	2,4
Рассеиваемая мощность при $\theta_{корп} = 85^\circ\text{C}$, мВт . .	100
Тепловое сопротивление корпуса в воздухе без об- дува, $^\circ\text{C}/\text{мВт}$	0,45